

96-0233

Изобретение относится к технологии выращивания кристаллов на основе возгоняемых веществ, которые могут быть использованы в оптоэлектронике.

Сущность изобретения состоит в том, что способ выращивания кристаллов из паровой фазы путем пересублимации в ампуле роста переменного диаметра включает нагрев исходного материала в зоне испарения, рост кристаллов на суженном конце ампулы, выполненном в виде открытого капилляра, конденсацию паров летучих примесей в холодной зоне, причем ампулу роста помещают в закрытую вакуумную систему, а конденсацию летучих примесей проводят при комнатной температуре.

Технический результат изобретения заключается в увеличении скорости массопереноса и повышении за счет этого скорости роста кристаллов и степени очистки от легколетучих и нелетучих примесей.

П. формулы: 1